


Проводники и диэлектрики в
электрическом поле.



▶ **Поляризованность (вектор поляризации)**

▶ Дипольный момент диэлектрика $\vec{p}_V = \sum \vec{p}_{li}$

▶ p_{li} – дипольный момент одной молекулы.

▶ **Поляризованность** диэлектрика – дипольный момент единичного объема:

$$\vec{P} = \frac{\vec{p}_V}{V} = \frac{\sum \vec{p}_{li}}{V}$$

▶ Для изотропного диэлектрика с неполярными молекулами:

$$\vec{P} = \vec{p}_l \cdot n = \alpha \varepsilon_0 n \vec{E} = \chi \varepsilon_0 \vec{E},$$

где n – концентрация молекул

$$\chi = \alpha \cdot n$$

диэлектрическая восприимчивость

▶ Связь между вектором P и σ' :

$$P_n = \sigma' = \chi \varepsilon_0 E$$

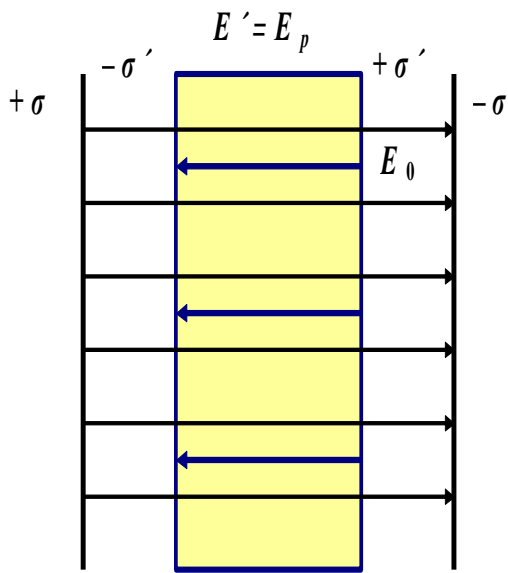
P_n – проекция вектора поляризованности на внешнюю нормаль к поверхности диэлектрика.

P_n численно равна электрическому заряду, смещаемому через единичную площадку в направлении положительной нормали к ней.



Поле в среде отличается от поля в вакууме тем, что оно создается как свободными, так и **связанными** (поляризационными) зарядами.

Теорема Гаусса
$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{своб} + q_{пол}}{\epsilon_0}$$



Свободные заряды создают внешнее поляризующее поле E_0 , а связанные заряды – добавочное поле поляризованного диэлектрика E_p .

$$\vec{E}_p \uparrow \downarrow \vec{E}_0$$

результатирующее поле в диэлектрике:

$$E = E_0 - E_p < E_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

вектор электростатической индукции (электрического смещения).

Закон Гаусса для вектора электростатической индукции

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{своб}$$

Поток вектора электростатической (электрической) индукции через замкнутую поверхность S равен алгебраической сумме свободных зарядов, охватываемых этой поверхностью.



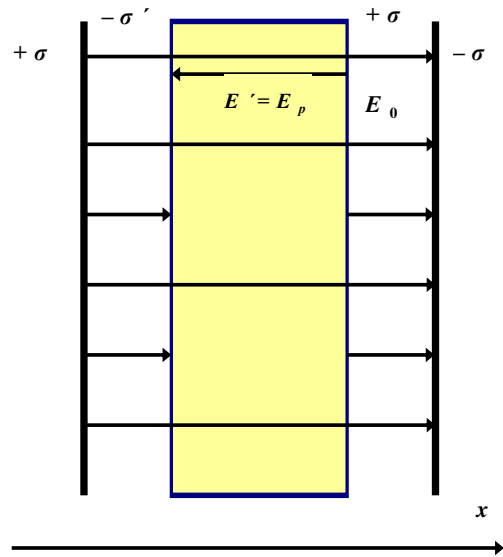
Связь между векторами D и E : $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$\varepsilon = 1 + \chi$ - относительная диэлектрическая проницаемость

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

Вектор D характеризует установившееся электрическое поле, создаваемое свободными зарядами, но при таком их распределении, какое имеет место при наличии диэлектрика.



Внешнее поле E_0 создается двумя бесконечными пластинами с поверхностной плотностью заряда $+\sigma$ и $-\sigma$.

Результирующее поле в диэлектрике $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

В проекциях на ось x : $E = E_0 - E'$

$$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \quad E = E_0 - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \quad P = \sigma' \quad \vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$E = E_0 - \frac{\chi \varepsilon_0 E}{\varepsilon_0} \quad E_0 = (1 + \chi) E \quad \varepsilon = 1 + \chi \quad \varepsilon = \frac{E_0}{E}$$

Относительная диэлектрическая проницаемость среды показывает во сколько раз поле в вакууме E_0 больше поля E в среде.

Задача 1. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком (слюдой, $\epsilon=7$). Площадь пластин конденсатора равна 50 см^2 . Определить поверхностную плотность связанных зарядов на слюде, если пластины конденсатора в отсутствие диэлектрика притягивают друг друга с силой 1 мН .

► Решение:

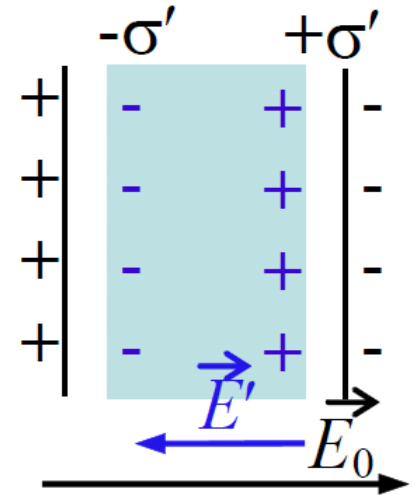
Напряженность поля в диэлектрике найдем по принципу суперпозиции:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \quad E = E_0 - E'$$

E_0 – напряженность поля конденсатора без диэлектрика,

E' – напряженность поля связанных зарядов,

E – напряженность поля в диэлектрике.



$$E = \frac{E_0}{\epsilon} \Rightarrow \frac{E_0}{\epsilon} = E_0 - E' \quad E' = E_0 - \frac{E_0}{\epsilon} = E_0 \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$$

$$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \quad \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) \Rightarrow \sigma' = \sigma \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$$

Пластины конденсатора притягиваются с силой $F = qE_0$, $q = \sigma S$ – заряд пластин.

$$\sigma = \frac{F \epsilon_0}{S} \Rightarrow \sigma' = \frac{F \epsilon_0}{S} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) \quad \sigma' = 11.4 \text{ мкКл/м}^2$$

Задача 2. Проводящий шар с равномерно распределенным зарядом 399 мкКл помещают в однородный изотропный диэлектрик с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 10$. Определить поляризованный заряд на границе диэлектрика с шаром.

► Решение:

При помещении шара в диэлектрик на его поверхности появляются отрицательные связанные заряды $-q'$, эти заряды создают поле напряженностью E' . Напряженность электрического поля шара, помещенного в диэлектрик определим по принципу суперпозиции полей: $E = E_0 - E'$,

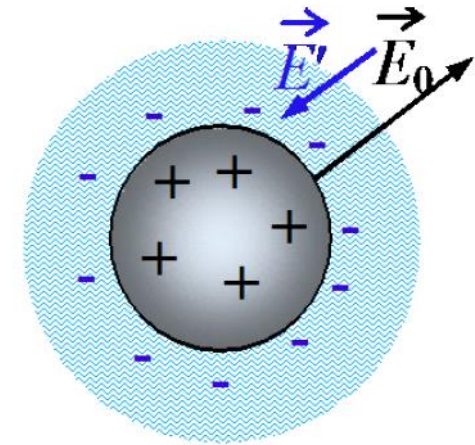
где E_0 – напряженность поля, создаваемая шаром, имеющим заряд q , E' – напряженность поля, создаваемая связанным зарядом $-q'$.

$$E_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad E' = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Поле в диэлектрике всегда меньше поля в вакууме в ϵ раз, т.е.

$$E = E_0/\epsilon, \text{ тогда получим: } \frac{E_0}{\epsilon} = E_0 - E'$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \frac{q}{\epsilon} = q - q' \quad \Rightarrow q' = q \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$$

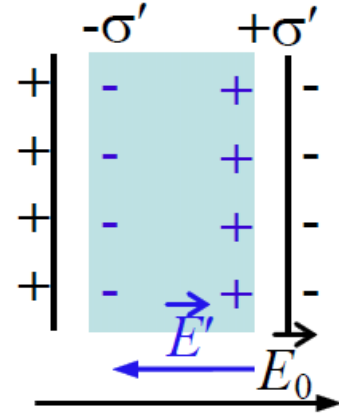


► $q' = 359.1 \text{ мкКл}$

Задача 3. Эбонитовая ($\epsilon = 3$) плоскопараллельная пластина помещена в однородное электрическое поле напряженностью 2 МВ/м. Грани пластины перпендикулярны линиям напряженности. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на гранях пластины.

► Решение:

При помещении пластины в электрическое поле в ней происходит перераспределение зарядов, таким образом, что на её противоположных гранях появляются отрицательные и положительные связанные заряды (см. рисунок), которые образуют электрическое поле с напряженностью E' .



Напряженность электрического поля E в пластине находится по принципу суперпозиции полей:

$$\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}_0$$

где E' - вектор напряженности электрического поля, созданного связанными зарядами; E_0 – вектор напряженности внешнего электрического поля.

В проекциях на горизонтальное направление получим:

$$E = E_0 - E'$$

$$E' = \sigma' / \epsilon_0$$

Поле в диэлектрике всегда меньше поля в вакууме в ϵ раз, т.е. напряженность поля в пластине $E = E_0 / \epsilon$, тогда:

$$\frac{E_0}{\epsilon} = E_0 - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \quad \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = E_0 - \frac{E_0}{\epsilon} \Rightarrow \sigma' = E_0 \epsilon_0 \left(1 - \frac{1}{\epsilon} \right) \quad \sigma' = 11.8 \text{ мкКл/м}^2$$

Задача 4. Обкладки плоского конденсатора имеют разноименные заряды по 90 нКл. Между обкладками находится диэлектрик, его относительная диэлектрическая проницаемость изменяется по закону $\varepsilon = \varepsilon(x)$ от $\varepsilon_1 = 45$ у положительной обкладки и до $\varepsilon_2 = 3$ у отрицательной обкладки. Определить суммарный связанный заряд q' , возникающий во всем объеме диэлектрика.

▶ Решение:

$$q' = \int \rho' dV$$

$$\operatorname{div} \vec{P} = -\rho' \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial x} = -\rho'$$

$$D = \varepsilon_0 E + P \quad D = \varepsilon \varepsilon_0 E$$

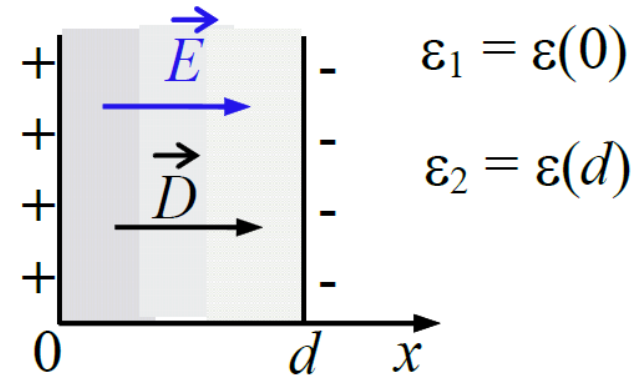
$$P = D - \varepsilon_0 E = D - \varepsilon_0 \frac{D}{\varepsilon(x) \varepsilon_0} = D - \frac{D}{\varepsilon(x)}$$

$$\oint (\vec{D}, \vec{dS}) = q \quad DS = q \Rightarrow D = \frac{q}{S}$$

$$P = \frac{q}{S} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right) \quad -\rho' = \frac{d}{dx} \left(\frac{q}{S} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right) \right)$$

$$q' = - \int \frac{d}{dx} \left(\frac{q}{S} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right) \right) S dx = - \frac{q}{S} S \int \frac{d}{dx} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right) dx = -q \int_{\varepsilon_1}^{\varepsilon_2} d \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right)$$

$$q' = -q \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(x)} \right) \Big|_{\varepsilon_1}^{\varepsilon_2} = -q \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 + \frac{1}{\varepsilon_1} \right) = q \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right) \quad q' = 28 \text{ нКл.}$$



Задача 5. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, проницаемость ε которого изменяется в перпендикулярном к обкладкам направлении по линейному закону от ε_1 до ε_2 , причем $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$. Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти:

а) емкость конденсатора;

б) объемную плотность связанных зарядов как функцию ε , если заряд конденсатора q и поле E в нем направлено в сторону возрастания ε .

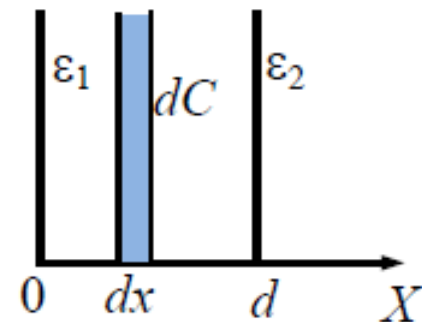
► Решение:

Выберем ось X по направлению возрастания диэлектрической проницаемости ε .

Величина диэлектрической проницаемости на расстоянии x от пластины определяется из соотношения:

$$\varepsilon(x) = a + bx = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d} x$$

$$a = \varepsilon_1, b = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}$$



Найдем теперь ёмкость плоского конденсатора. Для этого конденсатор представим как систему из последовательно включенных плоских конденсаторов, расстояние между пластинами которых dx . Ёмкость одного такого конденсатора dC :

$$dC = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon(x) S}{dx}$$



Задача 5. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, проницаемость ϵ которого изменяется в перпендикулярном к обкладкам направлении по линейному закону от ϵ_1 до ϵ_2 , причем $\epsilon_2 > \epsilon_1$. Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти:

а) емкость конденсатора;

б) объемную плотность связанных зарядов как функцию ϵ , если заряд конденсатора q и поле E в нем направлено в сторону возрастания ϵ .

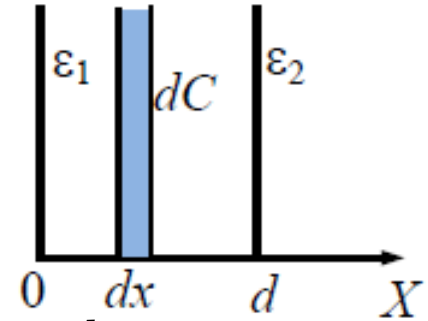
► Решение:

Так как полученная система представляет собой n последовательно включенных конденсаторов, то их общая ёмкость найдется следующим образом:

$$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{dC_i}$$

$$\frac{1}{C} = \int_0^d \frac{dx}{\epsilon_0 \epsilon(x) S} = \frac{1}{b \epsilon_0 S} \int_0^d \frac{d(a + bx)}{a + bx} = \frac{1}{b \epsilon_0 S} \ln \frac{a + bd}{a} = \frac{d}{\epsilon_0 (\epsilon_2 - \epsilon_1) S} \ln \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 (\epsilon_2 - \epsilon_1) S}{d \ln \epsilon_2 / \epsilon_1}$$



Теперь найдем объёмную плотность связанных зарядов ρ' . Известно, что

$$\operatorname{div} \vec{P} = -\rho'$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho'$$

в нашем случае, т.к. поле меняется только вдоль оси X

где P – модуль вектора поляризованности диэлектриков, который равен

►
$$P(x) = \epsilon_0 (\epsilon(x) - 1) E(x)$$

Задача 5. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, проницаемость ϵ которого изменяется в перпендикулярном к обкладкам направлении по линейному закону от ϵ_1 до ϵ_2 , причем $\epsilon_2 > \epsilon_1$. Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти:

- емкость конденсатора;
- объемную плотность связанных зарядов как функцию ϵ , если заряд конденсатора q и поле E в нем направлено в сторону возрастания ϵ .

► Решение:

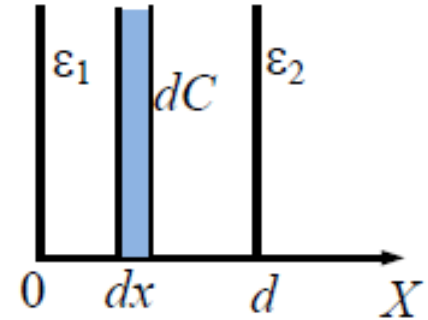
Найдем зависимость напряженности электрического поля между пластинами конденсатора, как функцию расстояния от одной из пластин. Для этого рассчитаем зависимость напряжения $U(x)$, полагая, что потенциал одной из пластин равен нулю

$$U(x) = \int_0^d dU(x)$$

где $dU(x)$ – разность потенциалов между пластинами конденсатора ёмкостью dC

$$dU(x) = \frac{q}{dC(x)} = \frac{q dx}{\epsilon_0 \epsilon(x) S} = \frac{q dx}{\epsilon_0 (a + bx) S}$$

$$U(x) = \int_0^x \frac{q}{\epsilon_0 S} \frac{dx}{(a + bx)} = \frac{q}{\epsilon_0 S b} \ln(a + bx)$$



Задача 5. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, проницаемость ϵ которого изменяется в перпендикулярном к обкладкам направлении по линейному закону от ϵ_1 до ϵ_2 , причем $\epsilon_2 > \epsilon_1$. Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти:

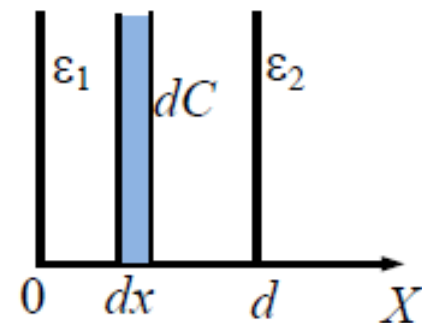
а) емкость конденсатора;

б) объемную плотность связанных зарядов как функцию ϵ , если заряд конденсатора q и поле E в нем направлено в сторону возрастания ϵ .

► Решение:

Напряженности электрического поля между пластинами конденсатора, равна

$$E(x) = -\frac{dU(x)}{dx} = -\frac{q}{\epsilon_0 S} \frac{x}{(a + bx)}$$



$$\rho' = -\frac{dP}{dx} = -\frac{d}{dx} \left(-\frac{q}{\epsilon_0 S (a + bx)} (a + bx - 1) \epsilon_0 \right)$$

$$= \frac{d}{dx} \left(\frac{q}{S} \left(1 - \frac{1}{a + bx} \right) \right) = -\frac{q}{S} \frac{b}{(a + bx)^2}$$

$$= -\frac{q (\epsilon_2 - \epsilon_1)}{S d} \frac{1}{(\epsilon_1 + (\epsilon_2 - \epsilon_1)x/d)^2}$$



Задача 6. Бесконечная пластина заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = 10$ нКл/м². С одной стороны пластины воздух, а с другой – масло ($\epsilon = 2$).

Определить напряженность поля в воздухе и масле.

▶ Решение:

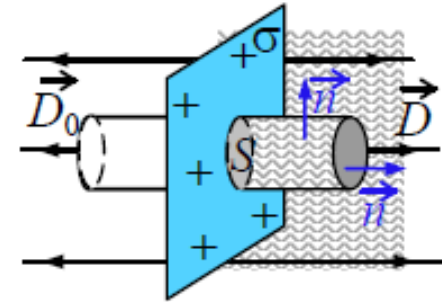
Поскольку справа и слева среда разная, то определим сначала вектор электрического смещения \mathbf{D} , а затем, зная связь между напряженностью \mathbf{E} и электрическим смещением \mathbf{D} , определим напряженность поля в разных средах.

Обозначим за \mathbf{D}_0 – вектор электрического смещения в воздухе, а \mathbf{D} – в масле, причем $\mathbf{D}_0 = \epsilon_0 \mathbf{E}_0$, $\mathbf{D} = \epsilon \epsilon_0 \mathbf{E}_0$, где \mathbf{E}_0 - напряженность поля в воздухе. Запишем теорему Гаусса для вектора \mathbf{D} .

$$\oint \vec{D}, \vec{dS} = q_{\text{свободн.}}$$

В качестве гауссовской поверхности выберем цилиндр, расположенный как указано на рисунке, тогда поток вектора \mathbf{D} будет определяться только потоком через торцы цилиндра, а через боковую поверхность он будет равен нулю.

$$\oint \vec{D}, \vec{dS} = D_0 S + DS = (D_0 + D)S = (\epsilon_0 E_0 + \epsilon \epsilon_0 E_0)S$$



Задача 6. Бесконечная пластина заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = 10$ нКл/м². С одной стороны пластины воздух, а с другой – масло ($\varepsilon = 2$).

Определить напряженность поля в воздухе и масле.

► Решение:

Суммарный заряд определим через поверхностную плотность зарядов

$$q_{\text{свободн.}} = \int \sigma dS = \sigma S$$

$$\Rightarrow (\varepsilon_0 E_0 + \varepsilon \varepsilon_0 E_0) S = \sigma S$$

$$(1 + \varepsilon) \varepsilon_0 E_0 = \sigma$$

$$\Rightarrow E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 (1 + \varepsilon)}$$

Напряженность поля в воздухе $E_0 = 377 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

Напряженность поля в масле

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0 (1 + \varepsilon)}$$

$$E = 188.5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

